

2011年3月期第2四半期決算説明会

2010年11月25日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

INDEX

1. 2011年3月期第2四半期決算の概要
2. 2011年3月期の業績見通し
3. ホロンのあたらしい展開

1. 2011年3月期第2四半期決算の概要

第2四半期損益(対予想比)

(単位:百万円)

	当初予想	10年9月期	対予想比	
	金額	金額	増減額	増減比(%)
売上高	120	162	42	35.2%
営業利益	△ 141	△ 86	55	—
経常利益	△ 142	△ 110	32	—
当期純利益	△ 143	△ 112	31	—

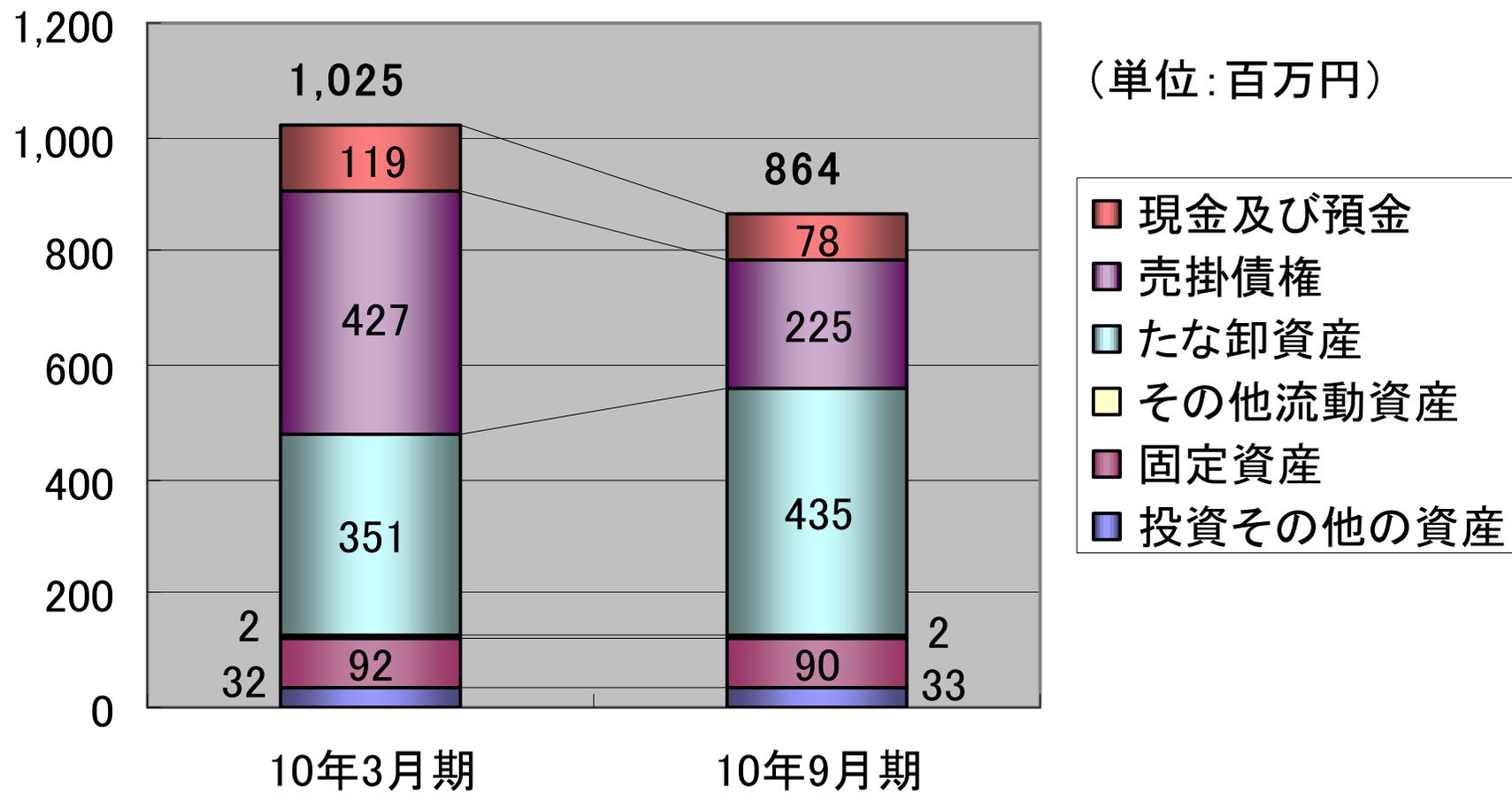
当初予想:平成22年5月14日に公表した数値を使用しております。

第2四半期損益(対前期比)

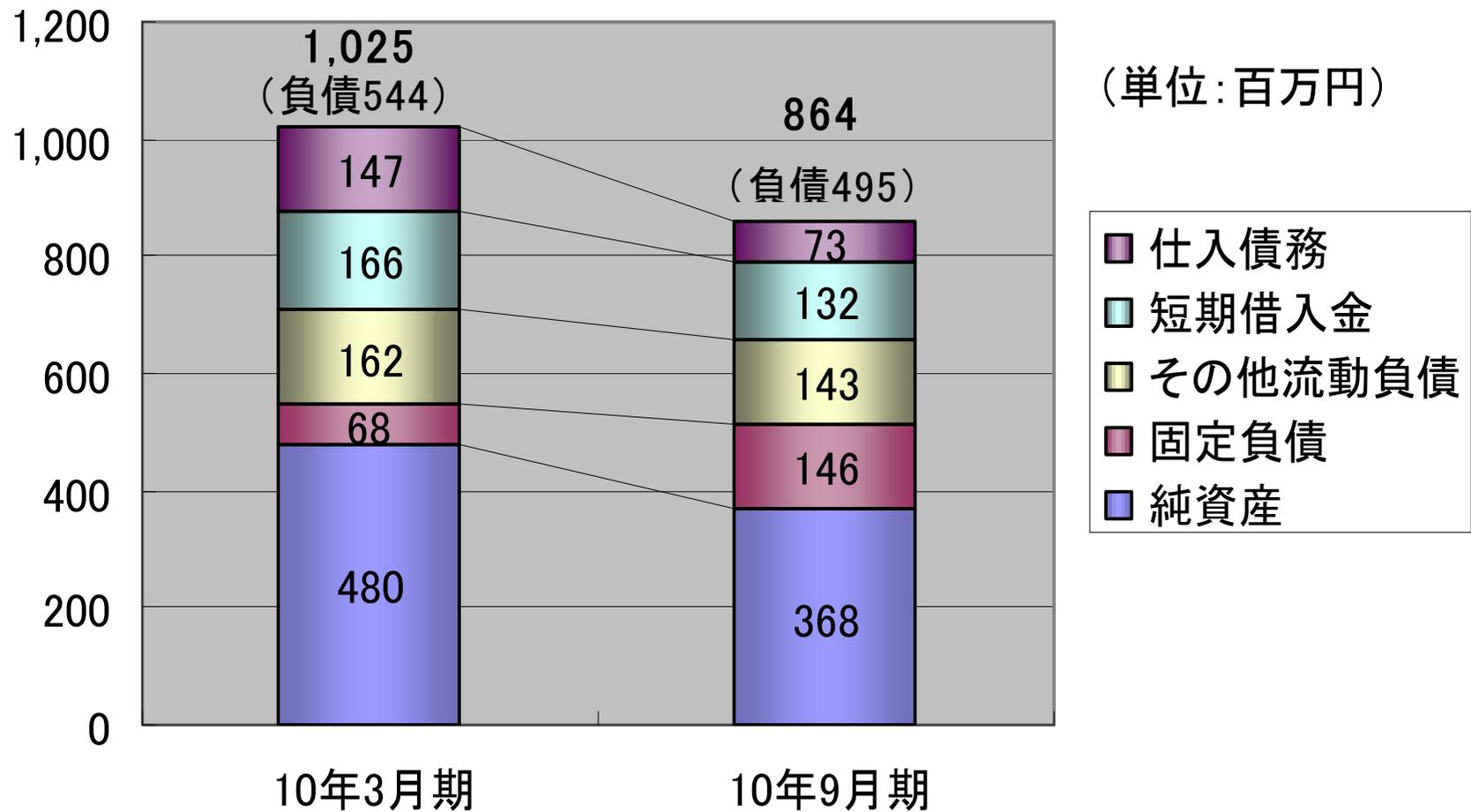
(単位:百万円)

	09/9期		10/9期		対前期比	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	増減額	増減比 (%)
売上高	585	100.0%	162	100.0%	△ 423	△ 72.3%
売上総利益	252	43.1%	76	46.9%	△ 176	△ 69.5%
販管費及び 一般管理費	247	42.2%	163	100.6%	△ 84	△ 33.7%
営業利益	5	0.9%	△ 86	—	△ 91	—
経常利益	8	1.4%	△ 110	—	△ 118	—
当期純利益	6	1.1%	△ 112	—	△ 118	—

資産の状況



負債・資本の状況

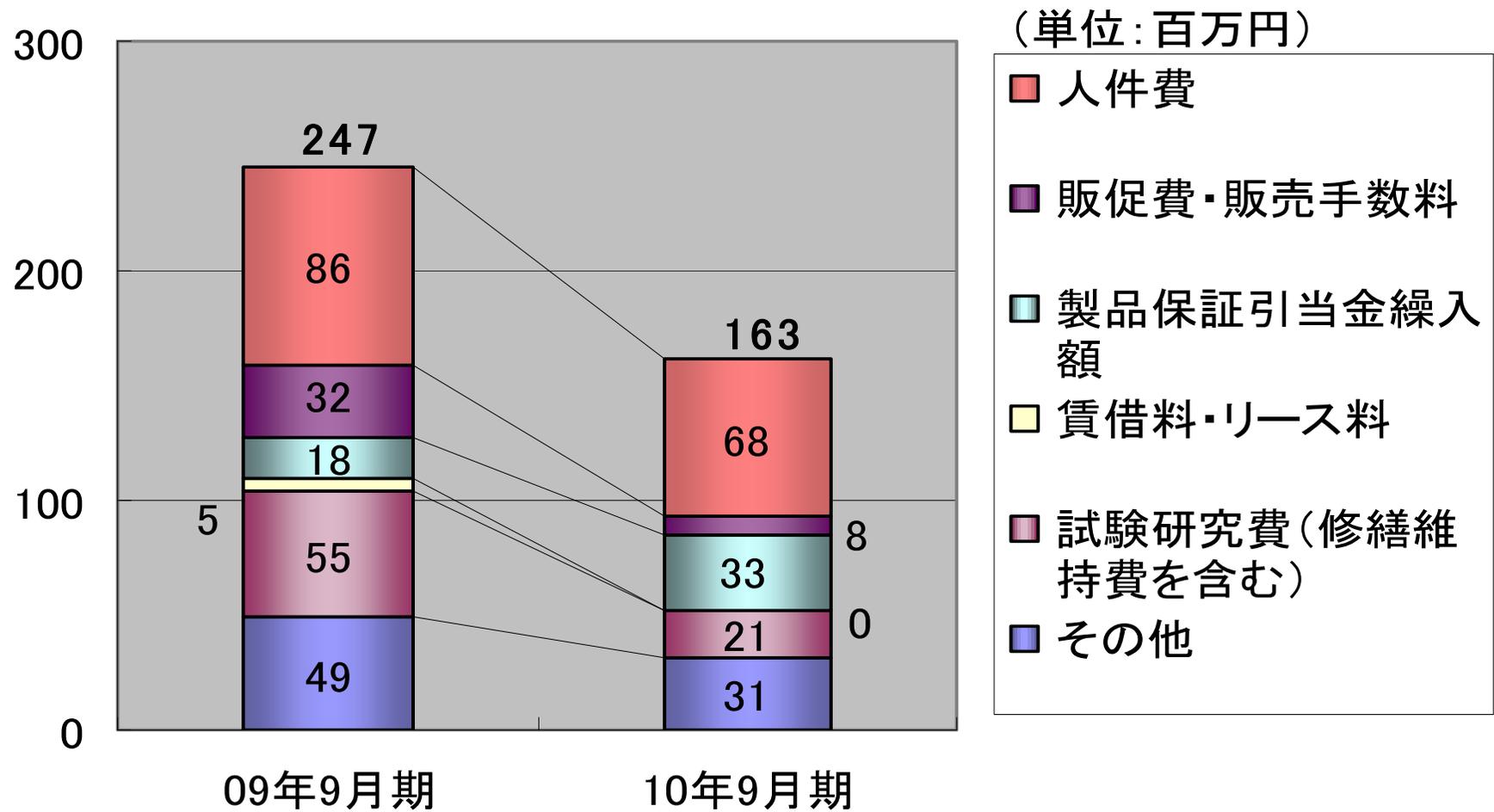


キャッシュフローの状況

(単位:百万円)

	09年9月期	10年9月期	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 132	△ 74	58
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 9	△ 4	5
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 8	40	48
現金及び現金同等物 の増加額	△ 148	△ 41	107
現金及び現金同等物 の期末残高	59	78	18

販管費の状況



2. 2011年3月期業績見通し

業績見通し

(単位:百万円)

	10/3期	11/3期 予想	増減額	増減率	(参考) 09/3期
売上高	1,151	838	△ 313	△27.2%	158
営業利益	30	40	10	31.8%	△ 639
経常利益	41	10	△ 31	△76.2%	△ 661
当期純利益	39	8	△ 31	△79.7%	△ 673

※平成22年11月9日に公表した数値を使用しております。

3. ホロンのあたらしい展開

今年度の重要施策

- I. 主力製品マスク**CD-SEM**の技術力向上
- II. 複数製品の製造・販売による経営の安定化

I. 主力製品マスクCD-SEMの技術力向上

New Model: Z7(新モデル名)を今月出荷

Z7

電子ビーム制御系を一新
標準1000x1000から
高精細4000x4000まで

さらに高性能化

EMU-270A

クリーン低真空で
チャージに強い
収差補正で高分解能



II. 複数製品の製造・販売による経営の安定化

NEDO事業の発展による新製品の開発

1. 電子ビーム高速検査
2. シームレスモールド露光
(EBLITHOから生まれた応用)

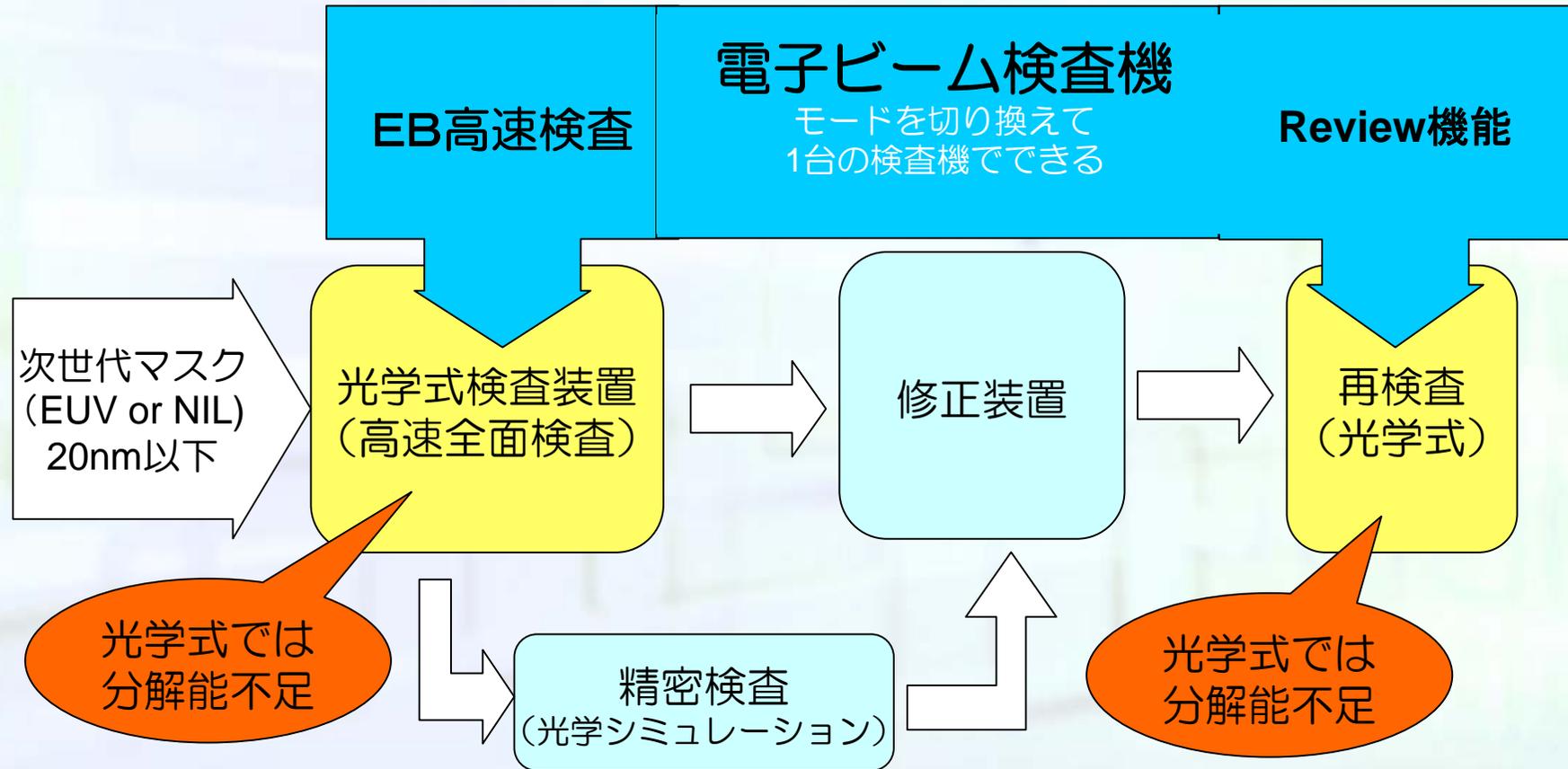
* EBLITHOのLEDへの応用について

EBLITHOの効果は実証済み

大手LEDメーカーの決断待ち

1.電子ビーム高速検査

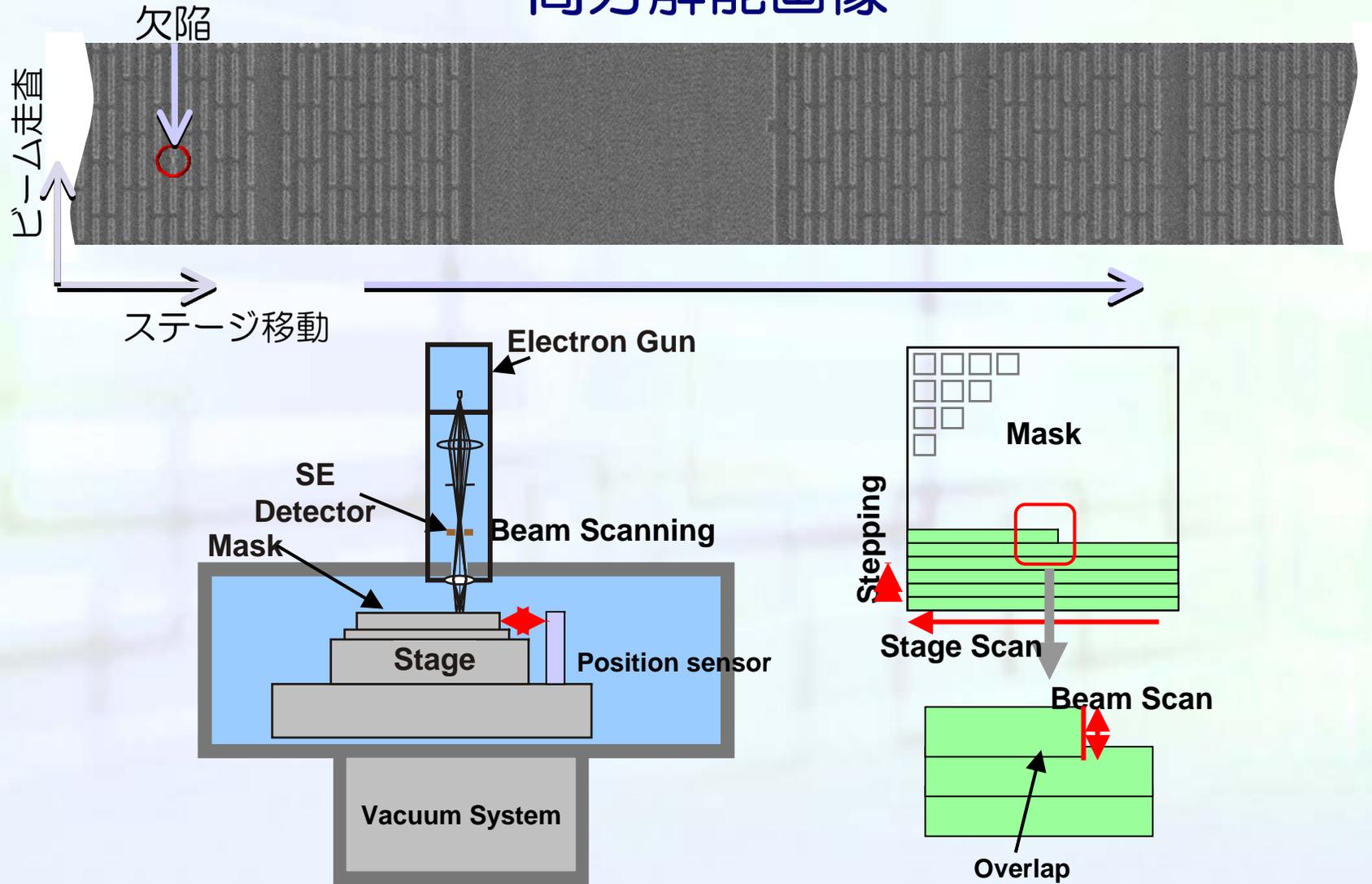
次世代リソ技術(EUVマスク、NILテンプレート) 対応



電子ビーム高速検査への期待

- ① 光学式検査の193nmの紫外線レーザーは22nm以降のマスク検査、とりわけ、コンタクトホールを検査には適用できない。
- ② EUVマスク用の検査装置は商用レベルのものが存在しない。
- ③ 露光波長と同じ波長をもちいた光学式検査は必要であるが、EUV光源が不安定、非常に大型で高額な装置となるなど使用は限定的である。
- ④ 現存する電子ビーム検査装置は遅すぎる。
従来技術400時間⇒新検査機12時間
- ⑤ 1台の装置で検査とレビューができる。

高速ビーム走査とステージ連続送りを組み合わせた 高分解能画像



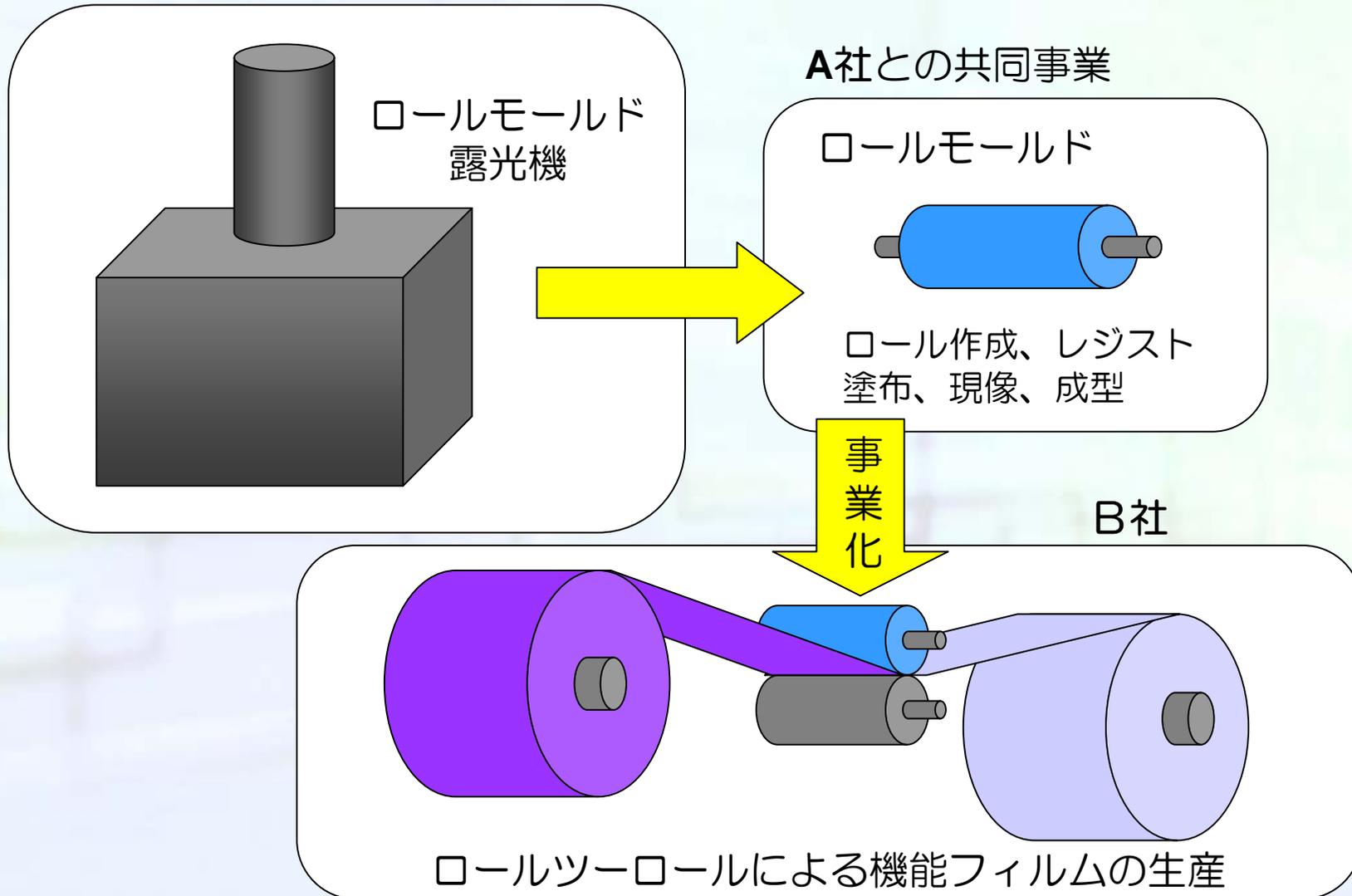
半導体技術状況

1. EUVリソグラフィーの実現が見えてきた。
2. EUV露光装置（≈100億円 オランダASML社）が有力デバイスメーカーに次々納入される。
3. EUVマスクの検査が重要となるも、要求仕様を満たす検査機は**まだない**。

ホロン 今後の展開

有力半導体メーカーへの販促活動開始

2. シームレスモールド露光



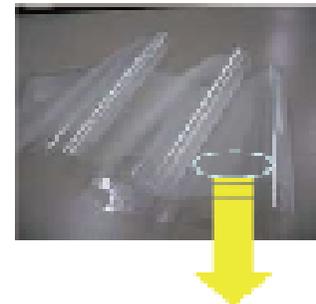
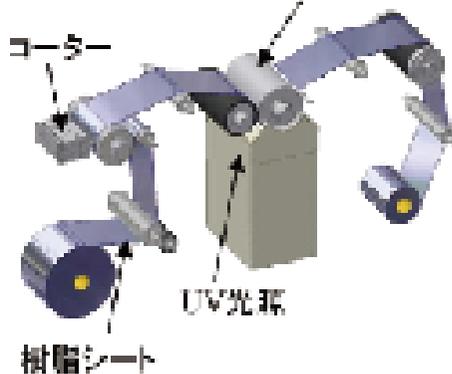
ロールツーロールナノインプリント技術

シートへの大面積・連続パターン転写

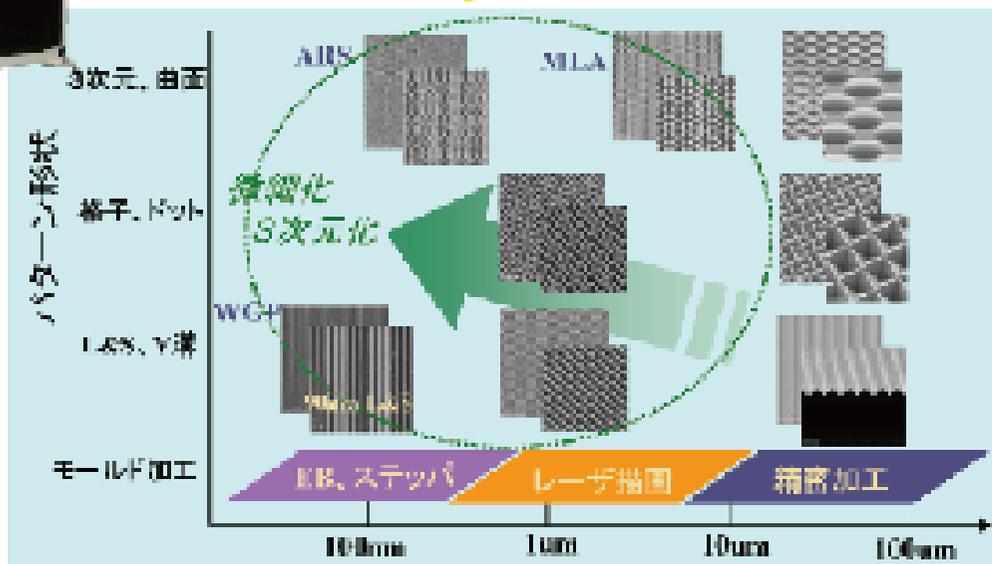


ロール式装置

ロール状金型



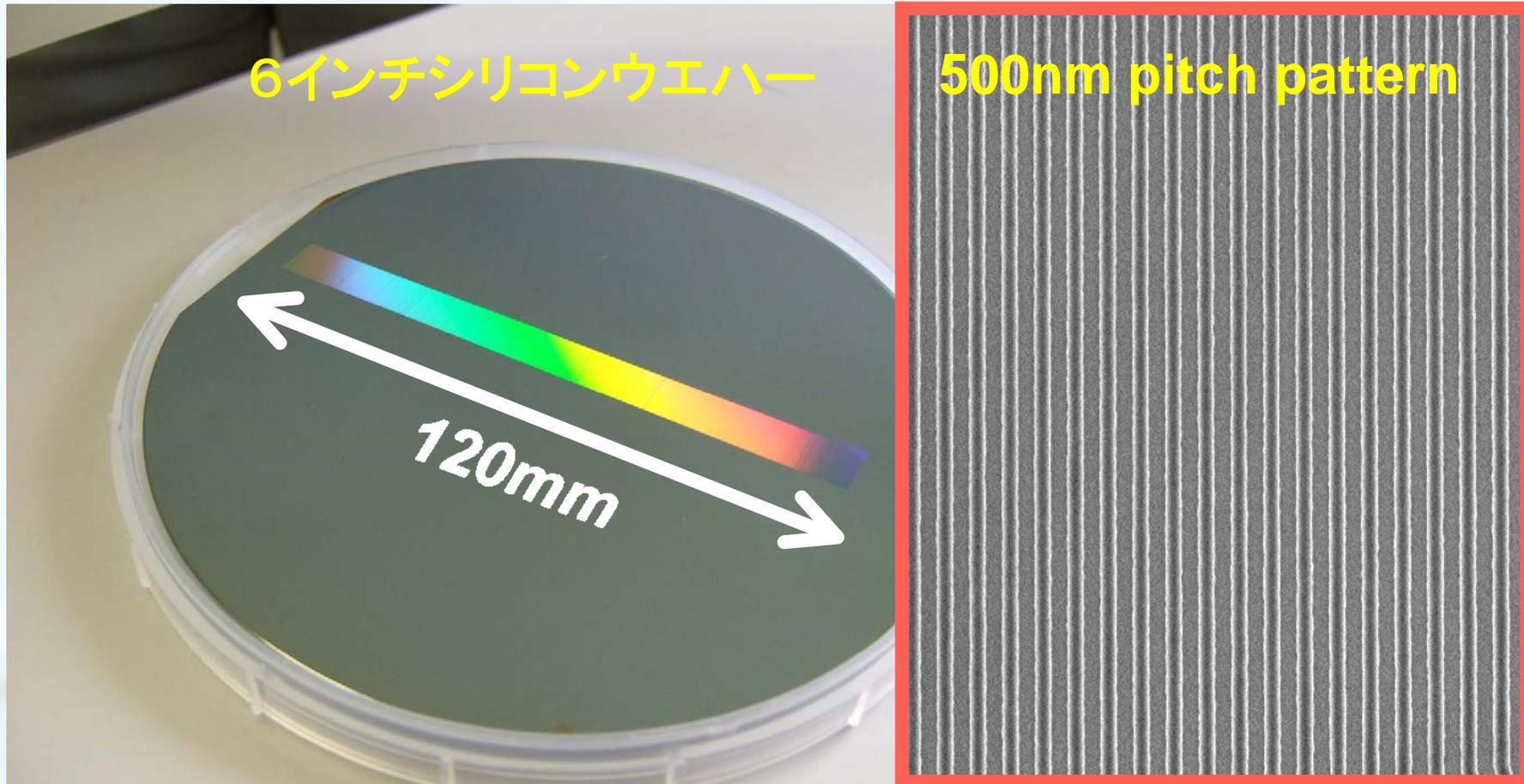
AIS: Anti Reflection Structure
MLA: Micro Lens Array
WGP: Wire Grid Polarizer



シームレスモールド露光への期待

- ① ナノパターンはEB露光でしか実現できない。光の制御（反射、偏向など）には300nm以下のパターンが必要。
- ② 既存のEB露光装置は、
 - 遅い（製作時間が膨大）
 - 高価（装置コストが高い）
- ③ 実用的な時間とコストでシームレスロールモールドを供給できる。

100mm以上連続ラインパターン形成の実証



10mm幅に200nm/500nmピッチ (20000本)を1回で製作
露光時間は最速20分を実現可能に！

ロールモールド露光装置完成

現在、ロールモールド
露光装置にて露光評価
しています

今後の展開

某有力メーカーと事業
化に向けて検討中

業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に株式会社ホロンが将来の見直しを見直すとは限りません。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準を原則として売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。